ホイスラー合金 Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb の強磁場中電気的および磁気的特性 Electrical and magnetic properties of Heusler alloys Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb under high magnetic fields

満永大輔¹,折橋広樹¹,島田大輔¹,廣井政彦¹,高橋 弘紀²,小山 佳一¹, 鹿児島大•理¹,東北大·金研²

D. Mitsunaga¹, H. Orihashi¹, D. Shimada¹, K. Takahashi² and K. Koyama¹ ¹ Graduate school of science and engineering, Kagoshima University ² Institute for Materials Research, Tohoku University

1. はじめに

近年,ホイスラー合金がハーフメタル特性や強磁性 形状記憶効果,熱電効果など数多くの機能性を持って いることが明らかになってきた. 主要なホイスラー型の合 金は, X は Co や Ni あるいは Cu 族の遷移金属元素 または貴金属元素,Y は Mn や V あるいは Ti 族の 遷移金属,ZはⅢ族からの典型元素で構成されている. 特に化学量論的組成を持つホイスラー合金としては, X₂MnZ (X=3d, 4d, 5d 金属, Z= s, p 元素), Co₂YZ (Y=3d, 4d, 5d 金属, Z= s, p 元素), Fe₂VZ (Z= Al, Ga, Si)について調べられている[1]. 結晶構造については, A, B, C, D の 4 つを副格子 とすると、その分数座標はそれぞれ(0 0 0),(1/4 1/4 1/4) , (1/2 1/2 1/2) , (3/4 3/4 3/4)で表わされる. A, C サイトは結晶学的に同等である.完全秩序状態(L21構 造:Cu₂MnAl 型, 空間群 No.225)の合金では X 原 子が A と C サイトを占め, B と D サイトをそれぞれ Y と Z 原子が占める. YとZ の原子が無秩序化すると結 晶構造は L21 構造から B2 構造に変化する. 今まで に一般的なホイスラー化合物(Cu₂MnAl型, 空間群 No.225)として Ni₂MnSb 等の磁気的, 電気的報告は研 究されており、その基礎特性について数多く報告されて いる.

一方, X = Mn の Mn₂YZ 化合物については X₂MnZ に比べてその報告例は少ない.その一例である Mn₂NiSb は強磁性体で,その結晶構造は Hg₂CuTi 型であり空間群は No.216 とほう[3].このとき, Mn が A (0 0 0)とB (1/4 1/4 1/4)サイトを占め, Ni が C (1/2 1/2 1/2)サイトを占め, Sb が D (3/4 3/4 3/4)サイトを占 めている.格子定数は 5.95 Åであると発表されている [4].そして最近, Hg₂CuTi 型の Mn₂NiSb について,磁 気特性とバンド計算より求めた電子構造等の報告[4]が あるが, 詳しくはない.

本研究の目的は Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb の x を変化させることにより、これらの電気的特性や磁気特性の強磁場による影響を明らかにすることである.

2. 実験詳細

多結晶 Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb(x = 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0)は、 Mn(99.9%), Ni(99.9%)および Sb(99.999%)の原料を化 学量論比で秤量し、アルゴンガス雰囲気中でアーク溶 解法を用いて合成した. アーク溶解は試料を裏返すな



Fig.1. Temperature dependence of the electrical resistivity of $Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb$ under a zero magnetic field.

どして繰り返し行われた.得られた試料は真空封入した後,温度 720℃,48 時間の均質化熱処理を行った.室 温での X 線回折測定によって,得られた試料が単相で あることを確認した.

強磁場中電気抵抗の測定は、東北大学金属材料研 究所附属強磁場超伝導材料研究センターで行われた. 直流4端子法を用いて、零磁場での温度変化4.2 $\leq T$ ≤ 230 K、温度一定(4.2 K)での磁場印加 0 $\leq B \leq$ 16 T の範囲で測定が行われた.さらに試料振動型磁 束計(VSM)を用いた高温磁化測定は温度 300 $\leq T \leq$ 723 K、印加磁場 0 $\leq B \leq 1$ T の範囲で行われた.

3. 電気抵抗測定

Fig.1 に零磁場における電気抵抗率 ρ の温度変化を 示す.零磁場において、 $Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb$ は組成によって T = 60 K で抵抗率の傾きに変化が見られた. Mn の割 合がNiよりも多い場合 (x ≤ 0.5),抵抗率の傾きが大きく なる. また Mn の割合が Niよりも少ない場合、抵抗率の 傾きは小さくなる、つまり得られた実験結果は、Mn と Ni の割合(組成)の違いで、電気抵抗率の振る舞いが異な り、フェルミ面付近の電子状態が両者で異なっているこ とを示唆している.



Fig.2. Magnetic field dependence of the electrical resistivity of $Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb$ (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75) at 4.2 K. Detailed data are presented in (b)-(e) for x = 0-0.75, respectively.

Fig.2 に 4.2 K における電気抵抗率の磁場変化を示 す.磁場印加 $0 \le B \le 16$ T の範囲で測定の結果、それ ぞれの組成で磁気抵抗の振る舞いが異なることが明ら かとなった.つまり、 $x = 0 \ge x = 0.5$ の電気抵抗率は磁場 に対してほとんど変化しないが、x = 0.25の電気抵抗 率は磁場増加とともに減少、B > 10 T の強磁場で一定 値に達する.一方、x = 0.75の電気抵抗率はB = 16 T まで磁場とともに減少する傾向がある。現在、これらの 振る舞いの起源については検討中である.

Fig.3 に $Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb$ の組成変化に対するキュリー温 度(T_C)を示す. x = 0 のとき T_C は約 650 K である. $Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb$ において、 $0.0 \le x \le 0.25$ では T_C は組成 に対し殆ど一定であるが、x = 0.5 では $T_C = 700$ K に達 する. 一方、 $0.6 < x \le 1.0$ では、x の増加とともにキュ リー温度が低下し、 $MnNi_2Sb$ (x = 1.0)では $T_C \sim 400$ K と なる. 単純な分子場モデルでは、交換積分が大きく変 わらないと仮定した場合、磁気モーメントが大きい程、 キュリー温度が高くなる. 一般に Mn と Ni の磁気モーメ ントを比べた場合、Mn の磁気モーメントが Ni のそれより



Fig.3. Curie temperature of $Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb$ (0.0 $\leq x \leq 1.0$).

大きいので、 $0.0 \leq x \leq 0.5$ の範囲でキュリー温度がほぼ 一定または上昇するとういことは、組成によって磁性原 子間の電子状態が変わり、磁気モーメントが誘起されて いる可能性がある. その後、x > 0.5 で磁気モーメントの 小さい Ni が増加することでキュリー温度の低下が見ら れたと思われる。現在、我々のグループでは詳細な電 子状態の計算を計画しており、強磁場実験とバンド計 算の両面からこれら物質の磁気特性を解明する予定で ある.

5. まとめ

L2₁型ホイスラー化合物 Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb 多結晶につい て、温度 4.2 $\leq T \leq 230$ K、印加磁場 0 $\leq B \leq 16$ T の範囲で電気抵抗測定と温度 300 $\leq T \leq 723$ K、 印加磁場 0 $\leq B \leq 1$ T の範囲で VSM による高温磁化 測定が行われた. 強磁場電気抵抗測定の結果、零磁 場において、Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb は温度の低下に伴い、組成 変化に対して T = 60 K で抵抗率の傾きに変化が見ら れた. また、温度一定の状態において磁場を印加する ことにより、電気抵抗の低下を一部の組成で観測された. 高温磁化測定の結果、Mn_{2-x}Ni_{1+x}Sb において、0.0 $\leq x \leq 0.6$ までは 高いキュリー温度が観測される. 0.6 $< x \leq 1.0$ では、キュリー温度が低下した.

謝辞

本研究は科研費 22360285 の助成を受けて行いました.

参考文献

- [1] R. Kainuma et al. Nature 439 (2006) 957-960.
- [2] 鹿又武. まてりあ 45 (2006) 165-171.
- [3] T. Graf et al., Z. Anorg. Allg. Chem. 635 (2009) 976-981.
- [4] H. Luo et al., J. Magn. Magn. Matter 321 (2009) 4063-4066.